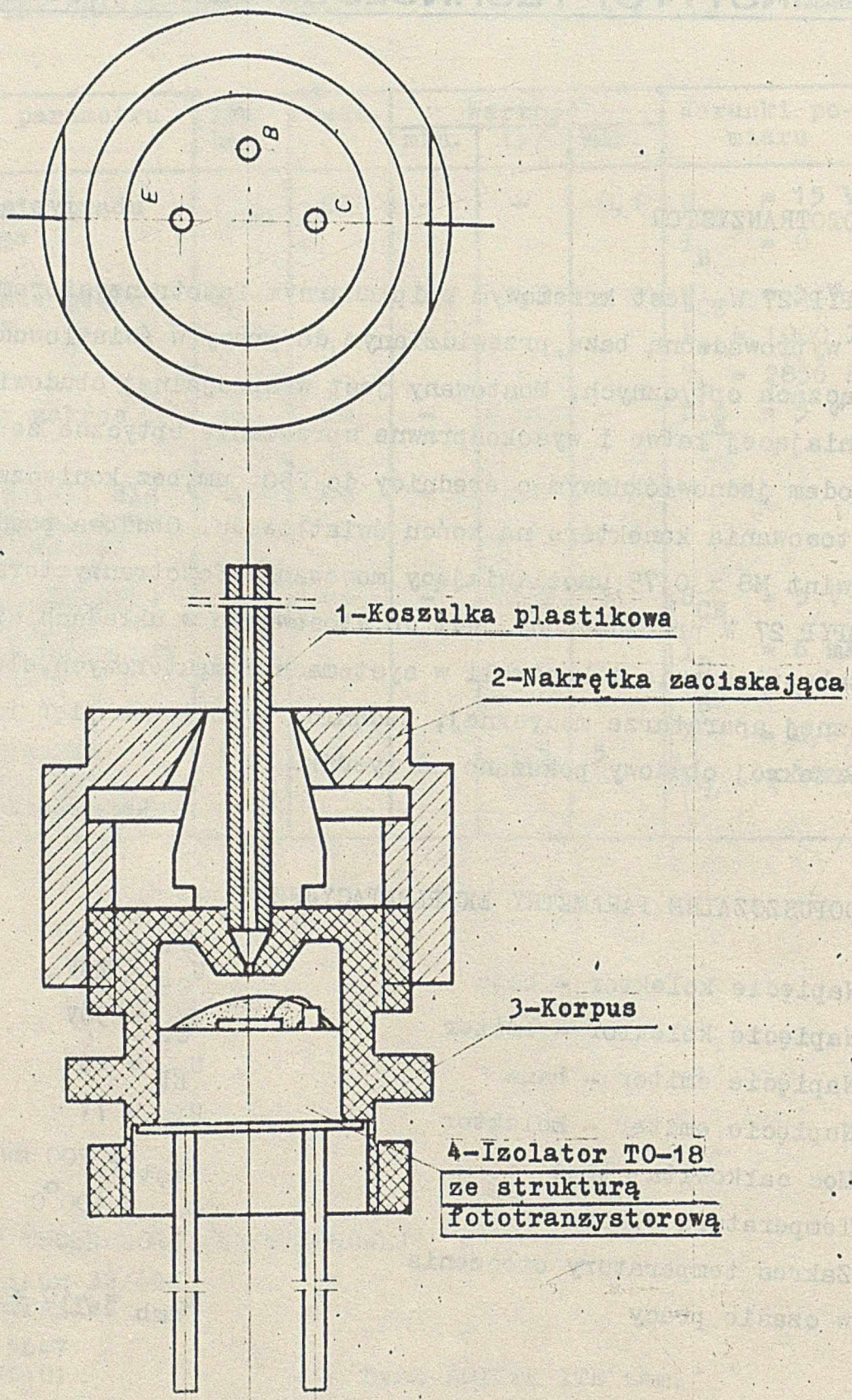
FOTOTRANZYSTOR BPYP 27 W

BPYP 27 W jest krzemowym epiplanarnym fototranzystorem n-p-n z wyprowadzoną bazą, przewidzianym do pracy w światłowodowych łączach optycznych. Montowany jest w specjalnej obudowie, zapewniającej łatwe i wysokosprawne sprzężenie optyczne ze światłowodem jednowłóknowym o średnicy do 250 µm, bez konieczności stosowania konektora na końcu światłowodu. Obudowa posiada gwint M8 x 0,75, umożliwiający mocowanie fototranzystora. BPYP 27 W przeznaczony jest do stosowania w układach sterowania, zabezpieczania i kontroli w systemach komputerowych, elektronicznej aparaturze medycznej, technice wysokich napięć i.t.p. Przekrój obudowy pokazano na rysunku 1.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

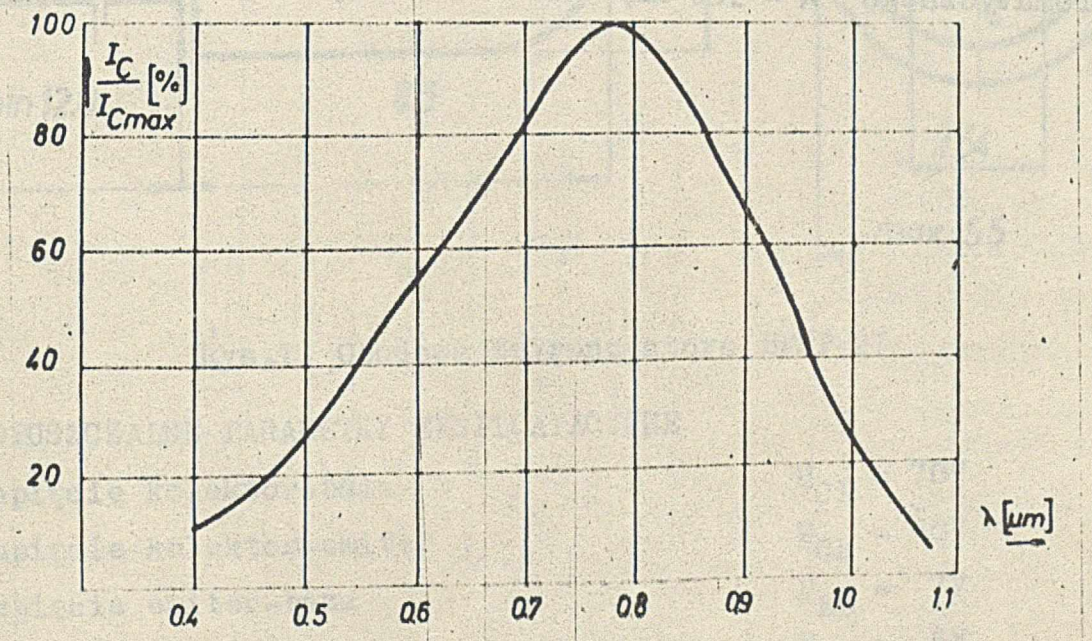
Napięcie kolektor - baza	$U_{CB} = 70V$
Napięcie kolektor - emiter	$U_{CE} = 50V$
Napięcie emiter - baza	$U_{EB} = 10V$
Napięcie emiter - kolektor	$U_{EC} = 7V$
Moc całkowita strat	$P_{tot} = 200$ mW
Temperatura złącza	$t_j = 100^oC$
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy	$t_{amb} = -40 \div +85^oC$



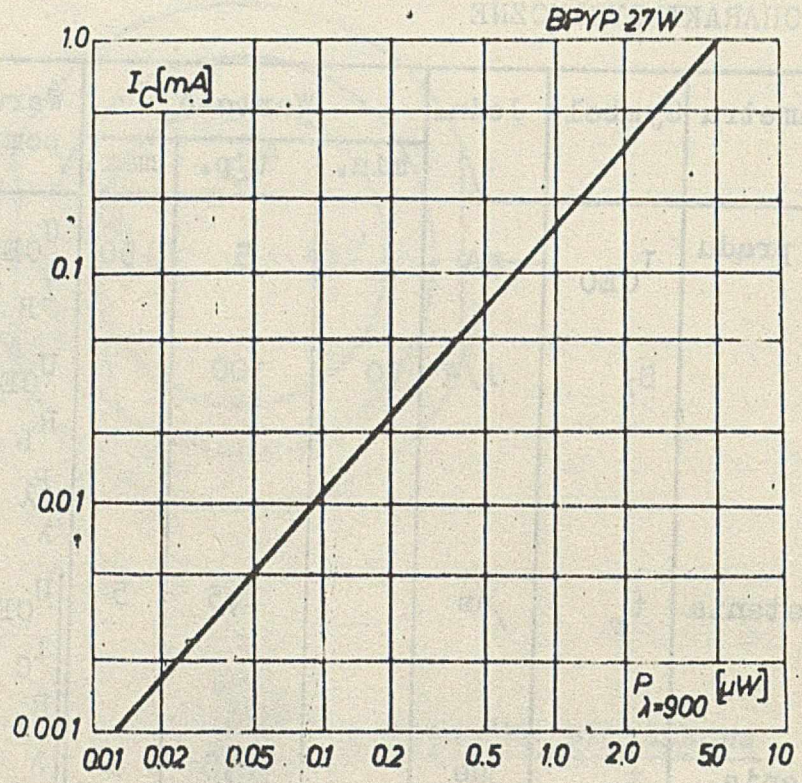
Rys.1. Przekrój przez obudowę fototranzystora BPYP 27 W

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru
			min.	typ.	max.	
Natężenie prądu ciemnego	I_{CEO}	nA		5	50	U_{CE} = 30 V I_B = 0
Czułość	S_λ	A/W	70	100		U_{CE} = 20 V R_L = 10 Ω P_λ = 50 nW λ = 900 nm
Czas narastania	t_r	μs		2,5	5	U_{CE} = 20V I_C = 1 mA R_L = 100 Ω λ = 900 nm
Czas opadania	t_f	μs		2,5	5	



Rys.2. Charakterystyka widmowa fototranzystora BPYP 27 W



Rys.3. Zależność prądu kolektora od mocy promieniowania monochromatycznego /λ = 900 nm/ dla fototranzystora BPYP 27 W.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al.Lotników 32/46 02-668 Warszawa
Tx: 815647, Tel: 435401

Druk ZOINTE ITE zam. 47/82 n 500

Cena 12 zł

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE